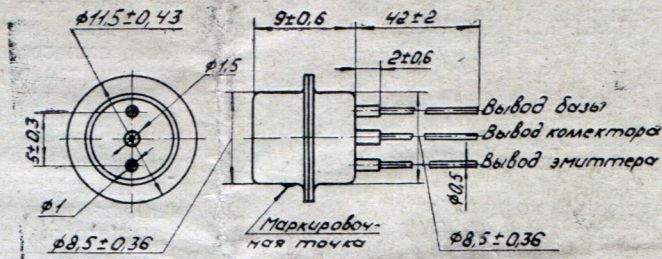


П А С П О Р Т

Транзисторы типов П417, П417А, П417Б.

Соответствуют техническим условиям 3.365.198 ТУ



Вес не более 2 г

Содержание драгоценных металлов в одном транзисторе: золота 0,1069 мг

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{amb} = +20 \pm 5^\circ\text{C}$

Наименование параметра, буквенное обозначение и режим его измерения	Единица измерения	Значения параметров транзисторов					
		П417		П417А		П417Б	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером $f_{гр}$, при $U_{св} = -5\text{В}$, $I_E = 5\text{мА}$	Мгц	200		200		200	
Обратный ток эмиттера $I_{Ево}$, при $U_{ЕВ} = -0,5\text{В}$	мкА		30		30		30
Начальный ток коллектора $I_{свс}$, при $U_{св} = -8\text{В}$, $R_{вЕ} = 5 \cdot 10^4 \text{Ом}$	мкА		5		5		5
Напряжение между коллектором и эмиттером при нулевом токе базы и заданном токе эмиттера $U(L)_{сЕ0}$, при $I_E = 5\text{мА}$, $Q = 10$	В	8		8		8	
Обратный ток коллектора $I_{сво}$, при $U_{св} = -10\text{В}$	мкА		3		3		3
Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме малого сигнала $h_{21е}$, при $U_{св} = -5\text{В}$, $I_E = 5\text{мА}$, $f = 50 + 1000 \text{Гц}$		24	100	65	200	75	250
Емкость коллекторного перехода C_c , при $U_{св} = -5\text{В}$, $f = 5 \cdot 10^6 \text{Гц}$	пф		5		5		6

2. ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование параметра режима	Буквенное обозначение	Норма параметра			Примечание
		П417	П417А	П417Б	
Максимально-допустимое напряжение между коллектором и эмиттером при отключенной базе, в при $t_{amb} = \text{минус } 40^\circ + +60^\circ\text{C}$	$U_{сЕ} \text{ max}$	-8	-8	-8	
Максимально-допустимое напряжение между эмиттером и базой в, при $t_{amb} = \text{минус } 40^\circ + +60^\circ\text{C}$	$U_{ЕВ} \text{ max}$	-0,7	-0,7	-0,7	
Максимально-допустимое напряжение между коллектором и эмиттером при короткозамкнутых электродах база-эмиттер, в при $t_{amb} = \text{минус } 40^\circ + +60^\circ\text{C}$	$U_{сЕ} \text{ max}$	-10	-10	-10	
Максимально-допустимый ток коллектора, ма, при $t_{amb} = \text{минус } 40^\circ + +60^\circ\text{C}$	$I_c \text{ max}$	10	10	10	
Максимально-допустимая мощность на коллекторе, мвт при $t_{amb} = \text{минус } 40^\circ\text{C} + +45^\circ\text{C}$	$P_c \text{ max}$	50	50	50	1
Минимально-допустимая температура окружающей среды, $^\circ\text{C}$	$t_{amb} \text{ min}$	-40	-40	-40	
Максимально-допустимая температура окружающей среды, $^\circ\text{C}$	$t_{amb} \text{ max}$	+60	+60	+60	
Максимально-допустимая температура перехода, $^\circ\text{C}$	$t_j \text{ max}$	+70	+70	+70	

Примечание. 1. Зависимость максимально-допустимой мощности на коллекторе от температуры окружающей среды от $+45^\circ\text{C}$ и выше выражается формулой:

$$P_c \text{ max} = \frac{70^\circ\text{C} - t_{amb}^\circ\text{C}}{0,5^\circ\text{C}/\text{мвт}}$$

3. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТРАНЗИСТОРОВ

Складские условия:

- температура окружающего воздуха от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 85%;
- отсутствие в окружающей среде кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Полевые условия:

- температура окружающего воздуха может изменяться в пределах от минус 40 до +40°C;
- относительная влажность воздуха может достигать 98% при температуре +30°C.

4. ГАРАНТИИ

Предприятие-изготовитель гарантирует срок службы транзисторов 10.000 часов. Гарантийный срок исчисляется с момента отгрузки транзисторов.

5. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Для повышения надежности транзисторов рекомендуется эксплуатировать в режимах ниже предельно-допустимых не менее, чем на 20—30%.

2. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора в течение времени не более 3 сек., температура пайки не выше плюс 260°C. За время соединения температура в любой точке корпуса транзистора и на переходах не должна превышать предельно-допустимую температуру окружающей среды и перехода соответственно.

3. Изгиб вывода допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора, при этом должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие неподвижность вывода между местом изгиба и стеклянным изолятором, чтобы не произошло нарушение спая вывода со стеклянным изолятором, ведущего к потере герметичности транзистора.

4. При эксплуатации транзистора следует учитывать возможность его самовозбуждения как высокочастотного элемента с большим коэффициентом усиления.

5. При эксплуатации транзисторов в условиях механических ускорений более 2 g транзисторы необходимо крепить за корпус.

6. РЕКЛАМАЦИИ

ОТК 100

Штамп ОТК

В случае преждевременного выхода транзистора из строя данный транзистор возвратит предприятие-изготовителю с указанием следующих данных:

Время хранения _____
(заполняется, если транзистор не был в эксплуатации)

Общее число часов работы транзистора _____

Основные данные режима эксплуатации _____
(причина снятия транзистора с эксплуатации или

хранения, количество транзисторов данного типа,

работавших в аналогичных условиях, но не отказавших и общее число часов работы их).

Сведения заполнил _____

ВНИМАНИЕ!

По окончании эксплуатации транзистора (если транзистор снят с эксплуатации после истечения срока гарантийной наработки) просим сообщить предприятию-изготовителю сведения, указанные в разделе 6.